

Ổ CỨNG 5 TB SẼ XUẤT HIỆN VÀO NĂM 2013

Công n

Công nghệ đầu đọc mới cho ổ cứng do Toshiba và đại học Tohoku (Nhật Bản) phát triển sẽ tăng mật độ lưu dữ liệu lên 1 terabit/ inch vuông, so với 178,8 gigabit/ inch vuông hiện nay, khiến dung lượng ổ cỡ 3,5 inch tăng lên tới 5 terabyte.

Kỹ thuật Nanocontact Magnetic Resistance tăng khả năng từ trở của đầu đọc gấp 2 lần, nghĩa là năng lực phát hiện sự thay đổi của trường điện từ sẽ cao hơn. Khác biệt lớn của từ trở nằm ở 2 vật liệu từ đặt sát nhau và nối với nhau bằng một điểm liên kết có kích cỡ 1 nanomet ở khoảng cách gần nhất.

Điều này có nghĩa là đầu đọc trở nên nhỏ hơn và đọc/ghi được các vùng từ nhỏ hơn trên bề mặt đĩa cứng. Các vùng từ này sẽ nằm sát nhau với mật độ dày hơn, khiến đĩa tăng thêm dung lượng.

Hiện nay các hãng như Toshiba, Seagate đang phát triển công nghệ ghi trực giao với mật độ lưu dữ liệu 150 gigabit/inch vuông. Còn công nghệ ghi từ nhiệt HAMR được hy vọng đạt tới 50 terabit/inch vuông vào năm 2019. Lúc đó, về mặt lý thuyết, các hãng có thể sản xuất được ổ 40 - 50 terabyte cỡ 2,5 inch.

Theo hãng nghiên cứu thị trường IDC, ngành công nghiệp ổ cứng năm 2011 sẽ tăng năng lực xuất xưởng gấp 4 lần so với 2006. Số lượng sản phẩm bán ra lúc đó sẽ đạt 675 triệu chiếc và doanh thu sẽ là 37 tỷ USD.